

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국



(10) 국제공개번호

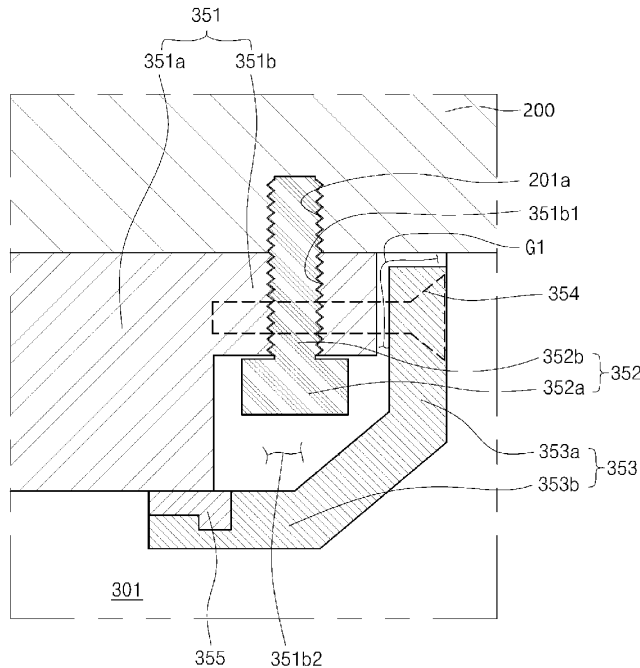
WO 2025/170418 A1

2025년 8월 14일 (14.08.2025) WIPO | PCT

- (51) 국제특허분류: H01J 37/32 (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2025/099227
- (22) 국제출원일: 2025년 2월 4일 (04.02.2025)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보: 10-2024-0019573 2024년 2월 8일 (08.02.2024) KR
- (71) 출원인: 피에스케이 주식회사 (PSK INC.) [KR/KR]; 18449 경기도 화성시 삼성1로4길 48 (KR).
- (72) 발명자: 김정재 (KIM, Jung Jae); 18449 경기도 정제 삼성1로4길 48 (KR).
- (74) 대리인: 권혁수 등 (KWON, Hyuk-Soo et al.); 06226 서울특별시 강남구 언주로 329, 4층 (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING DEVICE

(54) 발명의 명칭: 기판 처리 장치



(57) Abstract: The present invention relates to a substrate processing apparatus comprising: a processing chamber having a processing space; a plasma generation chamber having a discharge space for generating plasma from a processing gas; an adapter having a guide space for guiding the plasma generated in the discharge space to the processing chamber; and a baffle assembly disposed in the processing space, the guide space, or between the processing space and the guide space. The baffle assembly may comprise: a baffle plate having a plurality of baffle holes provided as passages for gas flowing between the guide space and the processing space; a coupling member for coupling the baffle plate to the processing chamber or the adapter; and a cover surrounding a coupling space in which the coupling member is located so that the coupling member is not exposed to the processing space.

[다음 쪽 계속]

WO 2025/170418 A1

TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

(57) 요약서: 본 발명은 기관 처리 장치에 관한 것으로, 처리 공간을 가지는 처리실과; 처리가스로부터 플라즈마를 발생시키는 방전 공간을 가지는 플라즈마 발생실과; 상기 방전 공간에서 발생된 플라즈마를 상기 처리실로 안내하는 가이드 공간을 가지는 어댑터와; 그리고 상기 처리 공간, 상기 가이드 공간, 또는 상기 처리 공간과 상기 가이드 공간 사이에 배치되는 배플 어셈블리를 포함하고, 상기 배플 어셈블리는 상기 가이드 공간과 상기 처리 공간 간에 흐르는 가스의 통로로 제공되는 복수의 배플홀이 형성된 배플 플레이트와; 상기 배플 플레이트를 상기 처리실 또는 상기 어댑터에 체결시키는 체결 부재와; 그리고 상기 체결 부재가 상기 처리 공간에 노출되지 않도록 상기 체결 부재가 위치되는 체결 공간을 감싸는 커버를 포함할 수 있다.